

Cu Pillar Plating

Cu Pillar Platingプロセス Systek BMP-LP8

半導体向け硫酸銅めっきのリーディングカンパニーであるMacDermid EnthoneがPLP (Panel Level Packaging) 向けの高速Cu Pillarめっきプロセスを開発しました。

特徴

- DC硫酸銅めっき
- ピラー径 80~200 μ m
- ピラー高さ 100~200 μ m
- 高電流密度による高速めっき対応 15A/dm²以上に対応
- 高純度銅析出
- CVS法による添加剤分析

| Anode type | Product | Sample info. | | Current Density | Plating Time | Target thickness |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | Temp. | D/F thickness | | | |
| Inert | SYSTEK BMP LP8 | 40C | 200 um | 18 ASD | 60 min | 200 um |

Dome bump, 8 μ m

